***• Memoria flash. También conocida como memoria sólo de lectura programable y borrable eléctricamente (Electrically Erasable Programmable Read- Only Memory, EEPROM), la memoria flash se diferencia de la memoria principal en que los datos pueden sobrevivir a los fallos del suministro eléctrico. La lectura de los datos de la memoria flash tarda menos de cien nanosegundos (un nanosegundo***

***es 0,001 milisegundo), lo que resulta aproximadamente igual de rápido que la lectura de los datos de la memoria principal. Sin embargo, la escritura de los datos en la memoria flash resulta más complicada (los datos pueden escribirse una sola vez, lo que tarda de cuatro a diez microsegundos, pero no se pueden sobrescribir de manera directa. (Abraham, 2002, pág. 249).***

***• Almacenamiento***